プログラム

09:00 –　　zoom オープン

09:15 – 09:30　　開会の辞

【オーラルセッション】ハイブリッド開催

座長： 北條 元 (九州大)

09:30 – 10:15　　INV-1： 強誘電体ナノスケール構造に特異な分極とその電場応答

○山田 智明 [1]

(1. 名古屋大学)

10:15 – 10:30　　Cont-1：層状ペロブスカイト強誘電体 $LaTaO_4$ 薄膜の作製

○浜嵜 容丞 [1]、森井 颯大 [1]、江原 祥隆 [1]、安井 伸太郎 [2]、澤井 眞也 [1]

(1. 防衛大、2.東工大)

10:30－10:45　　休憩 (15 分)

座長： 長浜 太郎 (山口大)

10:45 – 11:30　　INV-2：交差磁性に基づくスピントロニクス

○輕部 修太郎 [1]

(1. 京都大学)

11:30 – 13:00　　昼休憩 (90 分)

13:00 – 14:30　　【ポスターセッション】現地のみ

座長：安井伸太郎 (東工大)

P-1：マルチフェロイック $BiFeO_3$ 薄膜における転位構造解析

○冨永 一成 [1]、北條 元 [1]、伊藤 拓真 [2]、小野 大樹 [3]、重松 圭 [3]、小林 俊介 [4]、東 正樹 [3]、永長 久寛 [1]

(1. 九州大学、2. 物質・材料研究機構、3. 東京工業大学、4. ファインセラミックスセンター)

P-2：Investigation of the spin current generation in altermagnet RuO_2

○T. V. A. Nguyen[1,2]、V. T. N. Huyen[3]、Y. Saito[2]、S. DuttaGupta[1,3,4]、H. Naganuma[1,2]、S. Ikeda[1,2]、T. Endoh[1,2,5,6]

(1. CSIS、2. CIES、 3. IMR、4. Grad. Sch. of Eng.、5. RIEC, Tohoku Univ.、6. Saha Ins. Nuclear Phys, India)

P-3：Promotion of $L1_0$-ordering of FePd films by different heating method

○Samuel Vergara[1,2]、N. T. V. Anh[3,4]、H. Naganuma[3,4,5,6]

(1. Tohoku Univ.、2. ENS Paris-Saclay、3. CIES、4. CSIS, Tohoku Univ.、5. NAIAS, IMaSS、

6. Nagoya Univ.)

P-4：逆モンテカルロ法によるチタン酸ストロンチウムの局所構造解析

○上條 快[1]、中島 伸夫[1]、樊東暁[2]、Andris Anspoks[3]

(1. 広島大院先進理工、2. KEK-PF、3. ISSP, Univ. of Latvia)

P-5 : Antiferro/ferromagnetic coupling of ultrathin middle-MgO layer in multilayered CoFeB/MgO magnetic tunnel junction by micromagnetic simulation

○H. Naganuma[1,2,3]、T. V. A. Nguyen[1,2]、H. Honjo[1]、S. Ikeda[1,2,4]、T. Endoh[1,2,3,4]

(1. CIES、2. CSIS、3. Grad. Eng.、4. RIEC, Tohoku Univ.)

P-6：パイロクロア型酸化物磁性体 $Pr_2Ir_2O_7$ エピタキシャル膜の作製と物性

大石 舜士[1]、○長浜 太郎[2] (1. 北大工、2. 山口大工)

14:30 – 15:00　昼休憩 (30 分)

【学術変革 B 第 2 回研究成果報告会】ハイブリッド開催

座長： 大矢 忍 (東京大)

15:00－15:05　代表挨拶：大矢 忍 (東京大)

15:05 – 15:20　G-1：Giant spin-valve effect and gate modulation in nano-channel oxide devices made using metal-insulator transition

○Tatsuro Endo[1]、Shun Tsuruoka[1]、Yuriko Tadano[1]、Shingo Kaneta-Takada[1]、Yuichi Seki[1]、Masaki Kobayashi[1,2]、Le Duc Anh[1,2]、Munetoshi Seki[1,2]、Hitoshi Tabata[1,2]、Masaaki Tanaka[1,2,3] and Shinobu Ohya[1,2,3]

(1. The Univ. Tokyo、2. Cent. Spintronics Res. Net., The Univ. Tokyo、3. NanoQuine, The Univ. Tokyo)

15:20 – 15:35　G-2 : 非補償界面/cycloidal ハイブリッド型の反強磁性マルチフェロイックスの電気磁気効果

○永沼 博[1-4], 一ノ瀬 智浩[5]

(1. CIES、2. CSIS, 東北大、3. NAIAS、4. IMaSS, 名古屋大、5.AIST)

15:35 – 15:50　G-3：$LaAlO_3$ 基板上 $BiFeO_3$ 膜における未知結晶相および薄膜基板界面の高精度原子位置解析

○佐藤 幸生[1]、永沼 博[2,3]

(1. 熊大半デジ、2. 東北大、3. 名大)

15:50 – 16:05　G-4：スピントロニクス材料を対象とした有限温度伝導特性の第一原理計算

○福島 鉄也[1]、新屋 ひかり[2]

(1. 産総研、2. 東大 CSRN)

16:05 – 16:15　アドバイザー講評

16:15 – 16:30　閉会の辞

17:00 – 19:00　懇親会